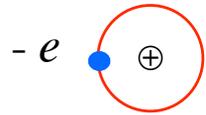


# 媒質について

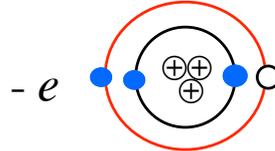
全ての物質は陽子，中性子，電子からなる。

プラスとマイナスの電荷は等しく，等量だけ存在



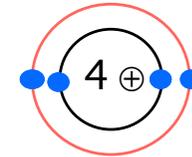
H

第一電子軌道  
-e 定員数 2



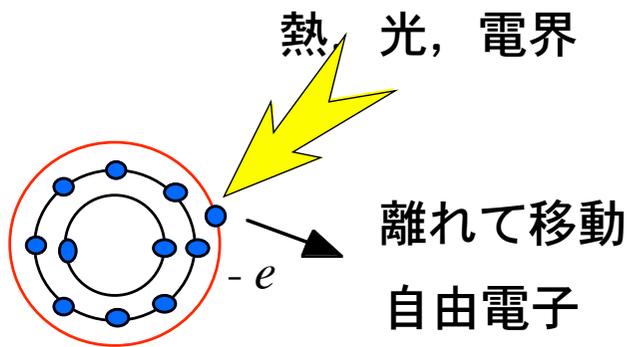
Li

最も外側の軌道に  
1つの電子



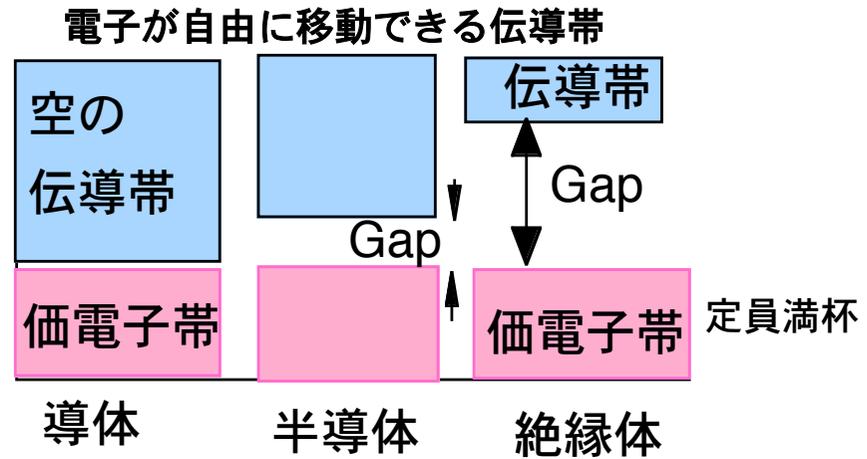
第2電子軌道  
定員数 8

最も外側の軌道に1つの電子



軌道間のエネルギーギャップ

エネルギーレベル



エネルギーGapが小さいほど  
伝導帯のレベルに移りやすい

導体

半導体

絶縁体

Conductor

Semi-conductor

Dielectrics

最も外側の電子軌道に  
1つの電子

中間

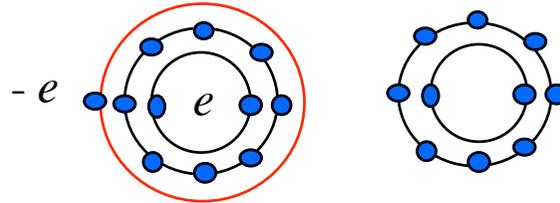
最も外側の電子軌道の  
電子定員数は満杯状態

電子は離れやすい

電気的には中性

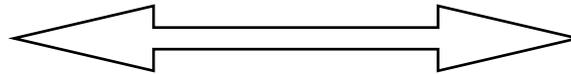
電子は束縛されている

自由電子が多数存在



電子は動けない

電気を通しやすい



電気を通さない

金属 銅 第4軌道  
銀 第5軌道  
金 第6軌道

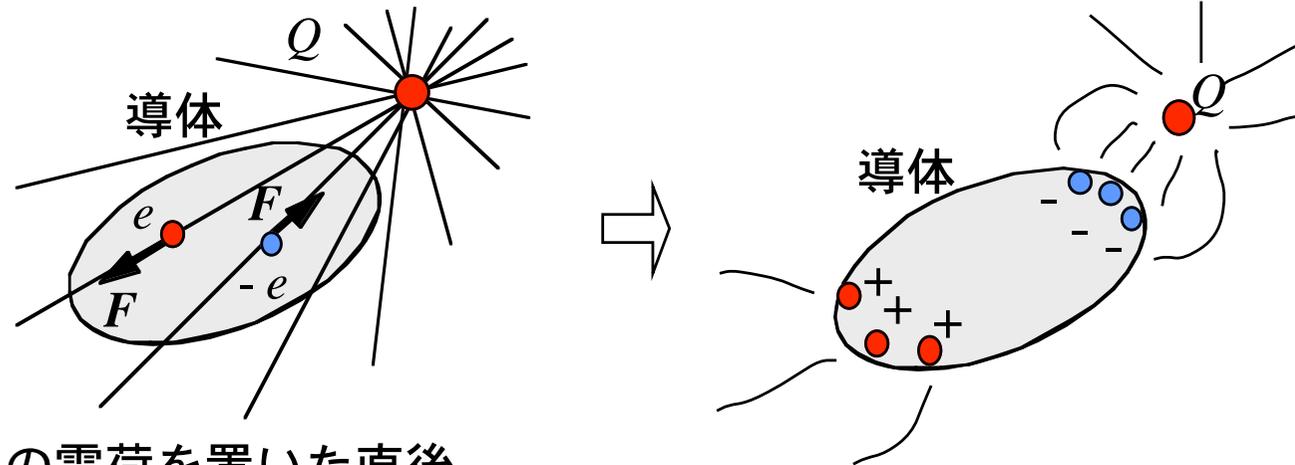
シリコン,  
ゲルマニウム

ガラス, プラスチック

完全導体

# 導体

自由に移動できる電子が多数存在



$Q$  の電荷を置いた直後  
クーロン力による電荷の移動

最終の平衡状態

静電誘導という

その結果 平衡状態になった場合

★ 導体内部の電界はゼロ  $E = 0$

$E \neq 0$  ならば, クーロン力による電荷の移動が続く

これから次ページの各種の重要な結論が得られる (続く)

基本式を使って導出可能な電界，電束，電位の特徴を考えよう

内部電界  $E = 0$

도체での特徴

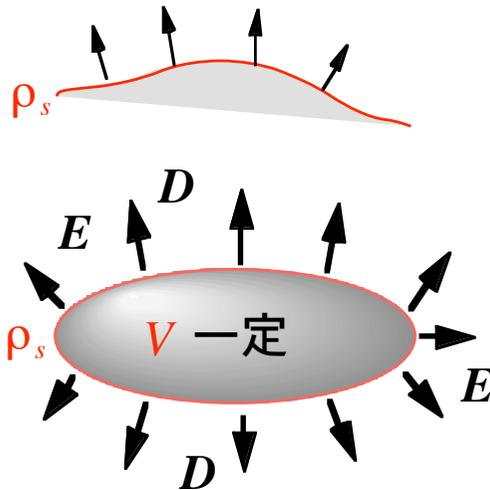
$$E = -\nabla V = 0 \implies V = \text{constant}$$

★ 導体の全ての位置で  
電位は同じ (等電位)

$$E = 0 \implies D = \epsilon_0 E = 0 \implies \nabla \cdot D = \rho = 0$$

$\rho_s$  表面電荷の形成へ  
導體表面は等電位面

★ 導体内に電荷は存在しない  
あればクーロン力が働き，  
電荷は表面に集まる

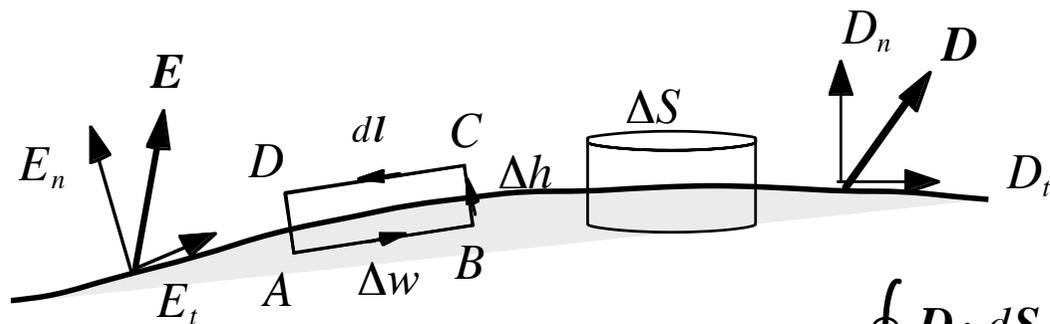


★ 表面の電荷から外部に向  
かって垂直に電界が発生

★ 電界の接線成分は 0

# 境界条件

外部電界，電束との関係を定式化（式で証明）



$$\oint E \cdot dl = 0$$

$$\int_A^B + \int_B^C + \int_C^D + \int_D^A = 0$$

$$-E_t \Delta w + \frac{\Delta h}{2} E_{n(C)} - \frac{\Delta h}{2} E_{n(D)} = 0$$

$$\Delta h \Rightarrow 0 \quad E_t = 0$$

内部では  
 $E = 0$

$$\oint_S D \cdot dS = Q$$

$$\int_{upper} + \int_{side} + \int_{lower} = Q$$

$$E_t = 0 \Rightarrow D_t = 0$$

$$\Delta h \Rightarrow 0 \quad D_n \Delta S = Q = \rho_s \Delta S$$

$$D_n = \rho_s$$

表面で

$D_t = E_t = 0$   
接線成分は 0

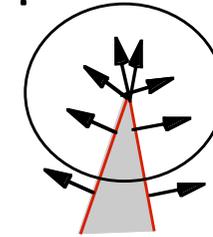
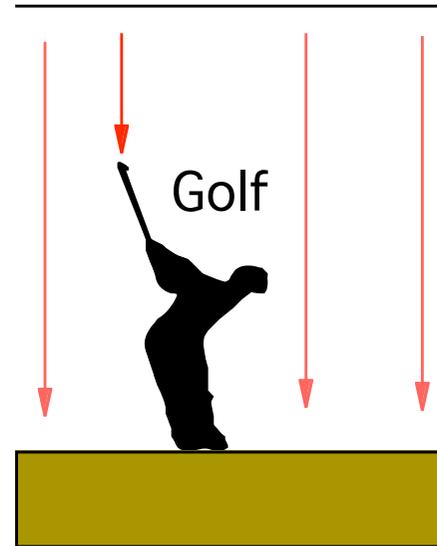
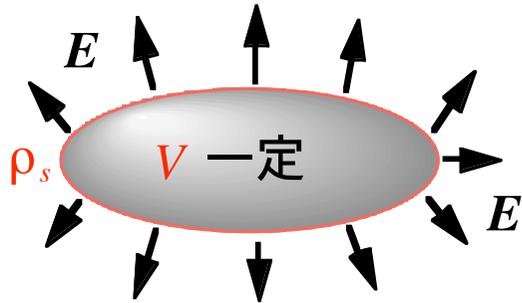
$D_n = \epsilon_0 E_n = \rho_s$   
法線成分のみ

電荷から  
電束が出る  
という考え方

電界は導体表面から垂直に出る！

$$D = \epsilon_0 E$$

角は？



避雷針の原理

導体の電位  $V_P = - \int_{\infty}^{inside} E \cdot dl$

$$= - \int_{surface}^{inside} E \cdot dl - \int_{\infty}^{surface} E \cdot dl = 0 - \int_{\infty}^{surface} E \cdot dl$$

導体内部で0

外部空間からの寄与のみ

★ 外部空間と金属の境界で電位は連続 (外部との関係)